



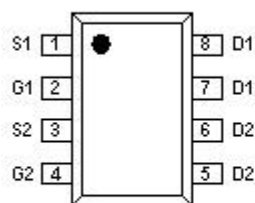
### TC4953ES (文件编号: S&CIC1647)

### 11V P 沟道增强型双 MOS 场效应管

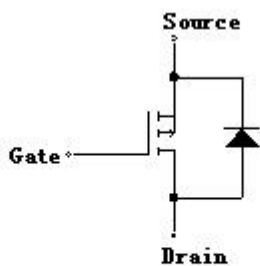
**VDS= -10V**

**RDS(ON), Vgs@-4.5V, Ids@-2A = 85mΩ@TYP**

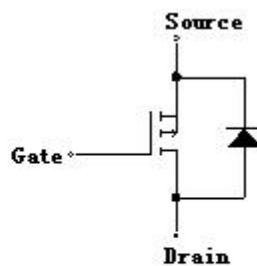
**RDS(ON), Vgs@-2.5V, Ids@-2A = 110mΩ@TYP**



SOP-8



P-Channel MOSFET  
MOS1



P-Channel MOSFET  
MOS2

### 特点

- 先进的 CMOS 工艺技术
- 更强的 ESD 保护, HBM>6kV
- 更低的开启电压, Vgs(th)=-0.6V

### 最大额定值和热特性(TA = 25°C, 除非另有说明)

参数	符号	值	单位
漏源电压	V <sub>DS1</sub>	-10	V
	V <sub>DS2</sub>	-10	
栅源电压	V <sub>GS</sub>	-5	
	V <sub>DS1</sub>	-10	
漏极电流	I <sub>D1</sub>	-2	A
	I <sub>D2</sub>	-2	
工作结温和存储温度范围	T <sub>J</sub> , T <sub>stg</sub>	-50 to 150	°C

注: 重复性极限值: 脉冲宽度由最高结温限制。



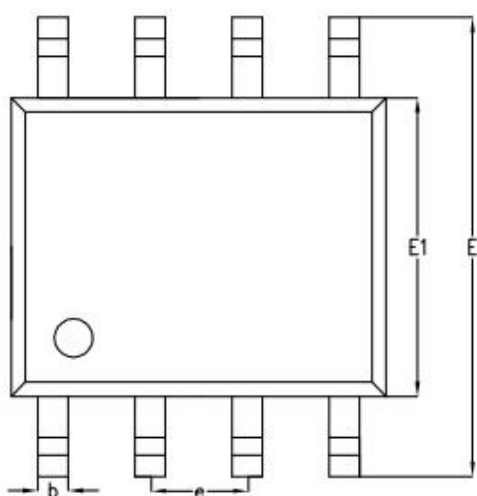
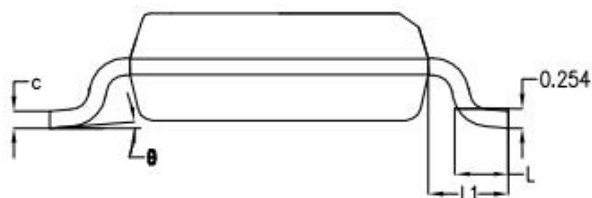
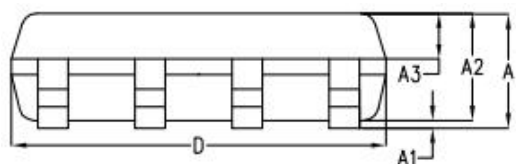
#### 电特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静电						
漏源击穿电压	$B_{VDSS1}$	$V_{GS} = 0V, I_D = -250\mu A$	-8	--	-10	V
	$B_{VDSS2}$	$V_{GS} = 0V, I_D = -250\mu A$	-8	--	-10	V
漏源电阻	$R_{DS1(on)}$	$V_{GS1} = -4.5V, I_{D1} = -2A, S1=S2=0V$	--	85	110.0	mΩ
	$R_{DS2(on)}$	$V_{GS2} = -4.5V, I_{D2} = -2A, S1=S2=0V$	--	85	110.0	
	$R_{DS1(on)}$	$V_{GS1} = -2.5V, I_{D1} = -2A, S1=S2=0V$	--	110.0	140.0	
	$R_{DS2(on)}$	$V_{GS2} = -2.5V, I_{D2} = -2A, S1=S2=0V$	--	110.0	140.0	
栅极阈值电压	$V_{GS1(th)}$	$V_{DS1} = V_{GS1}, I_D = -250\mu A$	-0.4	-0.6	-1	V
	$V_{GS2(th)}$	$V_{DS2} = V_{GS2}, I_D = -250\mu A$	-0.4	-0.6	-1	
漏极到源极的漏电流	$I_{DSS1}$	$V_{DS1} = -5V, V_{GS1} = 0V, T_J=25^\circ C$	--	--	-1	μA
	$I_{DSS2}$	$V_{DS2} = -5V, V_{GS2} = 0V, T_J=25^\circ C$	--	--	-1	
栅极到源极的漏电流	$I_{GSS1}$	$V_{GS1} = -5V$	--	--	-1	μA
	$I_{GSS2}$	$V_{GS2} = -5V$	--	--	-1	
漏极持续电流	ID1				-2	A
	ID2				-2	
漏极峰值电流	Ipk1				-4	A
	Ipk2				-4	



#### 封装信息

SOP-8



符号	毫米		
	最小值	典型值	最大值
A	-	1.50	1.55
A1	-	0.10	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.55	0.60	0.65
b	0.35	0.40	0.45
c	0.17	0.22	0.25
D	4.85	4.90	4.95
E	5.90	6.00	6.10
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.60	0.65	0.70
L1	1.05BSC		
θ	0°	4°	6°